

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

(11) N° de publication :  
le n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction

2 613 136

(21) N° d'enregistrement national :

88 04025

(51) Int Cl<sup>4</sup> : H 01 L 33/00; H 05 B 33/18; H 01 S 3/18.

## DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(12)

(22) Date de dépôt : 28 mars 1988.

(30) Priorité : JP. 27 mars 1987, n° Sho 62(1987)-71567, 25 septembre 1987, n° Sho 62(1987)-238655 et 29 décembre 1987, n° Sho 62(1987)-335866.

(43) Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 39 du 30 septembre 1988.

(60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(71) Demandeur(s) : Société dite : INCUBATOR, Japan Inc. et Société dite : MISAWA Co. Ltd. — JP.

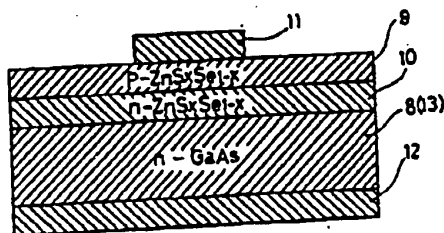
(72) Inventeur(s) : Hiroshi Kukimoto; Iwao Mitsuishi; Takashi Yasuda.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : Cabinet André Lemonnier.

(54) Élément électroluminescent et son procédé de fabrication.

(57) Une diode à luminescence bleue présente une structure à couches multiples, cristallisées sur un substrat cristallin semi-conducteur, du zinc, comme élément du groupe II de la classification périodique, du lithium, du sodium ou du potassium, comme éléments du groupe VI, étant utilisés. Ces derniers éléments et leurs composés sont utilisés en tant qu'impuretés à introduire dans la structure lorsqu'elle est en cours de cristallisation à partir d'une phase vapeur. Une diode à luminescence bleue présente une paire d'électrodes ohmiques et des couches semiconductrices de type n et des couches semiconductrices de type p. Ces couches sont cristallisées à partir d'une phase vapeur sur le substrat et prises en sandwich entre les électrodes.



FR 2 613 136 - A1

Elément électroluminescent et son procédé de fabrication.

La présente invention concerne les dispositifs à luminescence bleue, tels que des diodes à luminescence bleue (DELs) et les lasers à émission visible de courte longueur d'onde, et les technologies de fabrication de ces dispositifs.

5

De nos jours, des techniques de fabrication en série des diodes électroluminescentes qui émettent de la lumière visible, allant de la lumière rouge à la lumière verte, ont été établies, et des lasers qui émettent de la lumière visible, allant de la lumière rouge à la lumière jaune, sont en train de devenir d'usage pratique.

10 Les unités d'affichage qui utilisent ces dispositifs sont également en train de prendre de l'importance. Par conséquent, vont en augmentant le besoin et la demande en diodes électroluminescentes

À luminescence bleue, lesquelles ne sont pas fabriquées pour l'instant à l'échelle de la production en série, et en lasers à luminescence bleue et verte, lesquels ne sont pas encore fabriqués du tout. La lumière bleue est la seule couleur qui n'ait pas été réalisée à ce jour dans la famille des diodes électroluminescentes, et elle est nécessaire pour fabriquer des unités d'affichage avec un jeu complet de couleurs.

La première condition que doivent nécessairement remplir les matériaux pour diodes électroluminescentes et lasers à luminescence verte et bleue est que l'énergie de la bande interdite soit supérieure à 2,6 eV. SiC (2,6 eV), GaN (3,4 eV) et  $\text{ZnS}_{1-x}\text{Se}_x$  (2,7 - 3,8 eV) remplissent cette condition. L'autre condition pour fabriquer des dispositifs électroluminescents de haute efficacité est qu'une technique doit être disponible pour fabriquer de bonnes jonctions p-n avec une couche électroluminescente de haute qualité sur des substrats de grand diamètre.

Cependant, il existe une barrière importante à la réalisation de tels dispositifs électroluminescents. Les problèmes qui se posent pour chacun des matériaux sont les suivants. SiC ne présente pas de substrats appropriés pour la croissance épitaxiale, bien qu'une jonction p-n puisse être fabriquée. Il ne peut pas être effectué de jonctions p-n avec une émission lumineuse de haute efficacité dans GaN, parce que l'on n'a pas réussi à fabriquer de couche de type n en dépit de grands efforts. En outre, pour  $\text{ZnS}_{1-x}\text{Se}_x$ , on ne peut faire croître un cristal de type p que par une technique de cristallisation en solution, et, de ce fait, il

n'a pas été développé de technique de fabrication en série pour faire cristalliser des couches p-n sur des substrats de grand diamètre avec une bonne reproductibilité.

- 5 Les composés semiconducteurs des groupes II-VI, tels que  $ZnS_xSe_{1-x}$  ( $0 < x < 1$ ), présentent une large bande interdite, et ils constituent des semiconducteurs à transition directe qui se manifestent eux-mêmes comme étant des matériaux électroluminescents de haute efficacité. De plus, l'hétéroépitaxie des matériaux des groupes II-VI est possible sur des substrats de Si, Ge et/ou GaAs, avec une bonne harmonisation des constantes de réseau par le choix de la valeur x de la composition d'alliage. Une telle croissance épitaxiale est obtenue, soit par une technique de condensation de vapeur de substances chimiques organo-métalliques (Metal Organic Chemical Vapor Deposition - MOCVD), soit par une technique d'épitaxie par faisceau moléculaire (Molecular Beam Epitaxial - MBE).
- 15 En outre, la conductivité de type n peut être contrôlée par le dopage, soit d'éléments du groupe IIIb, soit d'éléments du groupe VIIb de la Classification Périodique. Cependant, un inconvénient important de ces matériaux est qu'on ne peut pas faire cristalliser des couches épitaxiales de type p par des techniques classiques. En raison de cela, il est impossible de fabriquer des diodes et des lasers semiconducteurs à luminescence bleue, étant donné que, pour de tels dispositifs électroluminescents, on doit faire
- 20 re cristalliser successivement des couches à la fois de type n et de type p.

Ainsi, les présents inventeurs ont développé une nouvelle techni-

que d'épitanie en phase vapeur pour faire cristalliser des couches de type p de  $ZnS_{1-x}Se_x$  présentant une faible résistivité, par dopage d'éléments du groupe Ia de la Classification Périodique, tels que le lithium (Li), le sodium (Na) et le potassium (K), à la condition que le rapport de flux des éléments du groupe VIb aux éléments du groupe IIb se situe dans la plage de 1 à 100.

Afin de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, la présente invention porte, de façon spécifique, sur des structures à couches multiples, qui consistent en couches semiconductrices II-VI de type n, ayant une conductivité qui se situe dans la plage de  $10^{-3}$  à  $10^3$  Ohm-cm, et en couches semiconductrices II-VI de type p, ayant une conductivité qui se situe dans la plage de  $10^{-3}$  à  $10^3$  Ohm-cm, toutes ces couches étant cristallisées par épitanie en phase vapeur sur des substrats semiconducteurs, en changeant de façon sélective la valeur x de la composition, avec harmonisation des constantes de réseau.

La présente invention porte également sur les procédés de fabrication de ces structures, suivant lesquels des gaz organo-métalliques pour les éléments du groupe II et des hydrures gazeux pour les éléments du groupe VI sont utilisés pour faire cristalliser en continu les couches semiconductrices II-VI à la fois du type n et du type p sur des substrats conducteurs harmonisés en ce qui concerne les constantes de réseau, à la condition que l'on fasse varier le rapport de flux des éléments du groupe II aux éléments du groupe VI de  $2 \times 10^{-3}$  à 10.

En résumé, comme cela a été mentionné ci-dessus, la présente invention repose sur le fait que :

- (1) l'on peut faire cristalliser en continu des structures de couches semiconductrices II-VI multiples, qui consistent en couches conductrices du type n et du type p, en utilisant une technique d'épitaxie en phase vapeur, sur des substrats semiconducteurs;
- (2) pendant la croissance épitaxiale, des éléments du groupe Ia, tels que Li, Na et K et leurs composés, sont introduits pour fabriquer des couches conductrices de  $ZnS_xSe_{1-x}$  de type p de faible résistivité, par exemple, en choisissant Zn en tant qu'élément du groupe IIb, et Se et S en tant qu'éléments du VI, pour former un cristal-hôte,  $ZnS_xSe_{1-x}$ , sur des substrats semiconducteurs tels que Si, GaAs ou GaP, et
- (3) par cristallisation alternée de couches du type p et de couches du type n, des dispositifs à luminescence bleue à jonction p-n, sont fabriqués, de façon uniforme et avec une bonne reproductibilité, sur lesdits substrats semi-conducteurs de grand diamètre, pour lesquels des techniques de fabrication en série ont déjà été établies; et
- (4) la présente invention conduit ainsi à une technique de fabrication en série, avec un rendement élevé, de dispositifs à luminescence bleue, avec lesquels des dispositifs d'affichage, à l'état solide, avec les couleurs au complet, utilisant des dispositifs à luminescence rouge, verte et bleue, sont susceptibles d'être fabriqués à une grande échelle.

Avec la présente invention, étant donné que les éléments du grou-

pe Vb de la Classification Périodique sont dopés simultanément aux éléments du groupe Ia, les lacunes en atomes-hôtes VI, qui sont produites par l'occupation des dopants Ia, sont compensées par les éléments Vb dopés, ce qui réduit les défauts ponctuels et améliore la qualité du cristal.

Avec ce co-dopage d'éléments Ia et Vb, les éléments Ia, qui sont mobiles dans les conditions normales, peuvent former une liaison avec les éléments Vb placés dans la position voisine dans un réseau cristallin et, de ce fait, ils peuvent être stabilisés. Par conséquent, la mobilité des éléments Ia est supprimée, et, de ce fait, on s'attend à des caractéristiques stables et à une longue durée de vie pour les dispositifs électroluminescents fabriqués par la technique conforme à la présente invention.

La présente invention sera décrite plus en détail ci-après, avec référence au dessin annexé, sur lequel:

La figure 1 illustre un exemple des modes de réalisation de la présente invention, obtenu par un appareillage MOVPE (Metal Organic Vapor Phase Epitaxial Technique), pour fabriquer des dispositifs électroluminescents conformes à l'invention; la figure 2 illustre un deuxième mode de réalisation de la présente invention, par un appareillage MBE (Molecular Beam Epitaxial Technique); et la figure 3 représente une vue en coupe transversale d'un mode de réalisation de la structure des dispositifs électroluminescents.

La figure 1 illustre un exemple de modes de réalisation de l'invention, à savoir un appareillage MOVPE de fabrication de dispositifs électroluminescents, tels que des diodes électroluminescentes à luminescence bleue, et des lasers à émission visible (dans le bleu et le vert). Le chiffre de référence 1 désigne un récipient en un des éléments IIb, par exemple Zn, qui est une source d'un atome-hôte dans un semiconducteur II-VI, les chiffres de référence 2 et 3 désignent des récipients en un des éléments VIb, tels que Se et S, qui sont des sources d'éléments VI dans le cristal-hôte. Le chiffre de référence 4 désigne un récipient d'impuretés, telles que Li, Na ou K ou leurs composés. Tous les atomes-hôtes et toutes les impuretés sont alimentés de façon sélective, à partir de ces récipients, au tube réacteur 5 qui est réalisé en silice. Un dispositif de chauffage à haute fréquence 6 chauffe un suscitateur en graphite 7, introduit dans le réacteur 5, et la température du substrat semiconducteur 8, par exemple, une pastille de GaAs, qui est placé sur le suscitateur 7, est élevée. La structure à couches multiples, qui consiste, par exemple, en une couche 9 semiconductrice II-VI de type p sur une couche 10 semiconductrice II-VI de type n, cristallisée sur un substrat 8 semiconducteur III-V de type n, comme représenté sur la figure 3, peut alors être formée par une croissance épitaxiale continue en phase vapeur. Les chiffres de référence 11 et 12 de la figure 3 désignent des électrodes par contact ohmique.

25

La figure 2 illustre un autre exemple des moyens de réalisation de l'invention, à savoir un appareillage MBE qui est utilisé pour la



fabriation de la structure conforme à la présente invention. Sur cette figure, le chiffre de référence 16 désigne un creuset chauffé par une résistance chauffante, et le chiffre de référence 17, une enveloppe de protection refroidie par de l'azote liquide. Un 5 suscitateur en molybdène 14 est placé au centre de l'enveloppe de protection 17 refroidie par l'azote liquide, et un substrat semiconducteur 13 est placé sur le suscitateur 14. La structure représentée sur la figure 3 est formée par la croissance épitaxiale continue d'une couche semiconductrice II-VI de type n, telle qu'une 10 couche 10 de ZnSe de type n, et une couche semiconductrice II-VI de type p, telle qu'une couche 9 de ZnSe de type p sur un substrat 8 de GaAs.

Sur cette figure 3, le chiffre de référence 8 désigne un substrat 15 de GaAs, et une couche cristalline unique semiconductrice de type n, telle qu'une couche 10 de  $\text{ZnS}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x = 0,08$ ), ou de ZnSe, est cristallisée sur ledit substrat 8. Le chiffre de référence 9 désigne  $\text{ZnS}_{1-x}\text{Se}_x$  ou ZnSe de type p. Pour former ledit  $\text{ZnS}_{1-x}\text{Se}_x$  de type p, des éléments Ia, tels que Li, et des éléments Vb, tels que N, 20 sont dopés simultanément. Une jonction p-n est formée entre ladite couche 9 de type p et ladite couche 10 de type n. Le chiffre de référence 12 désigne un contact ohmique pour le matériau de type n, et le chiffre de référence 11, un contact ohmique pour le matériau de type p.

25 Dans la structure de diode électroluminescente représentée sur cette figure, étant donné que des éléments Vb, tels que N, sont dopés en même temps que des éléments Ia, les défauts de réseau peu-

vent être réduits par comparaison avec le cas où seulement un élément Ia est dopé, en tant qu'accepteur, pour réaliser une conductivité de type p. Jusqu'ici, il était dit que les lacunes de Se sont produites par des éléments Ia, tels que Li, qui forment une liaison avec les éléments II, tels que Zn, dans un réseau.

Contrairement au fait ci-dessus, le co-dopage d'éléments Vb, tels que N, avec des éléments Ia, pendant l'épitaxie en phase vapeur, supprime la production des défauts ponctuels, étant donné que les lacunes de Se sont remplacées par des éléments V dopés, tels que N. Ainsi, on peut faire croître un film de cristal de type p épitaxialement en phase vapeur avec une très faible concentration en défauts ponctuels, même en cas de concentration élevée en impuretés.

Avec ce co-dopage de Li et de N, Li qui est mobile dans les conditions normales, peut former une liaison avec N à la position voisine dans un réseau cristallin et, de ce fait, il devient immobile. Par conséquent, le mouvement de Li est supprimé, et on s'attend à des caractéristiques stables et à une longue durée de vie des dispositifs électroluminescents. La couche épitaxiale 8 de type n et la couche épitaxiale 10 de type p peuvent être formées par une croissance épitaxiale continue, soit à l'aide de l'appareillage MOVPE, soit à l'aide de l'appareillage MBE.

La présente invention n'est pas limitée aux cas mentionnés ci-dessus, mais elle s'étend également à d'autres cas, par exemple, dans la couche 9 de  $ZnS_xSe_{1-x}$  de type p, Na et K peuvent remplacer Li, en tant qu'accepteur, et du phosphore (P) et de l'arsenic (As) peu-

vent être utilisés à la place de N.

En outre, sur la figure 3, le substrat 8 est du GaAs de type n, mais du GaAs de type p peut être utilisé aussi. Dans ce cas, une  
5 couche de type p est d'abord cristallisée sur le substrat de type p, puis une couche de type n est cristallisée sur la précédente, pour former des dispositifs à luminescence bleue qui possèdent des caractéristiques analogues à celles du dispositif représenté sur la figure.

10

Dans les exemples de modes de réalisation décrits ici, la valeur de  $x$  de la composition d'alliage de  $\text{ZnS}_x\text{Se}_{1-x}$  est choisie pour être de 0,08, afin d'harmoniser les constantes de réseau; alors, la lumière émise est une lumière bleue et le rendement quantique  
15 est augmenté d'un facteur 2. Cependant, on peut faire varier la valeur de  $x$  de la composition en fonction de la couleur désirée, autrement dit de la longueur d'onde de la lumière, et le substrat le plus approprié peut être choisi de telle sorte que les constantes de réseau s'harmonisent entre elles. Dans ce cas,  $x$  doit être tel  
20 que  $0 < x < 1$ .

#### EXEMPLE 1

Du zinc-diéthyle ( $\text{DEtZn}$ ), du sélénure de diéthyle ( $\text{DEtSe}$ ) et du  
25 nitrure de lithium ( $\text{Li}_3\text{N}$ ), ont été utilisés comme matériaux sources pour la cristallisation d'une couche de  $\text{ZnSe}$  de type p. Ces matériaux en phase vapeur ont été transportés dans une chambre de réacteur 5, telle que celle représentée sur la figure 1, avec un

véhicule gazeux constitué par de l'hydrogène. A des débit de  $1 \times 10^{-4}$  mole/mn pour DETZn, de  $2 \times 10^{-4}$  mole/mn pour DETSe, et de  $3 \times 10^{-4}$  mole/mn pour Li<sub>3</sub>N, on a fait cristalliser épitaixialement une couche de ZnS<sub>0.92</sub>Se<sub>0.08</sub> de type p, d'une épaisseur de 1  $\mu$ m, avec une concentration en véhicule de  $8,8 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> et une résistivité de 0,19  $\Omega$ cm, sur un substrat 8 de GaAs, monté sur un suscitateur en graphite 7, chauffé à 450°C.

### EXEMPLE 2

10 Du zinc-diéthyle (DETZn), du sélénure de diéthyle (DETSe), du sulfure de diéthyle (DETS) et du nitrure de lithium (Li<sub>3</sub>N), ont été utilisés comme matériaux sources pour la cristallisation d'une couche de ZnS<sub>0.92</sub>Se<sub>0.08</sub> (x  $\approx$  0,08) de type p. La cristallisation a été effectuée dans le même système que celui utilisé à l'Exemple 1. A des débits de  $1 \times 10^{-4}$  mole/mn pour DETZn, de  $2 \times 10^{-4}$  mole/mn pour DETSe, de  $5 \times 10^{-4}$  mole/mn pour DETS et de  $3 \times 10^{-9}$  mole/mn pour Li<sub>3</sub>N, on a fait cristalliser une couche de ZnS<sub>0.92</sub>Se<sub>0.08</sub> (x  $\approx$  0,08) de type p, d'une épaisseur de 1  $\mu$ m, avec une concentration en véhicule de  $5,8 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> résistivité de 0,5  $\Omega$ cm, sur un substrat de GaAs, à 450°C.

### EXEMPLE 3

25 On a fait cristalliser une couche de ZnS<sub>0.92</sub>Se<sub>0.08</sub> (x  $\approx$  0,08) de type p, présentant une concentration en véhicule de  $4,5 \times 10^{17}$  cm<sup>-3</sup> et une résistivité de 0,8  $\Omega$ cm, sur un substrat de GaAs, à 300°C, par épitaixie par faisceau moléculaire. La configuration des matériaux

sources, Zn, S, Se et  $\text{Li}_3\text{N}$  dans la chambre de cristallisation, est représentée schématiquement sur la figure 2. Les températures des sources de Zn, S, Se et  $\text{Li}_3\text{N}$  ont été maintenues respectivement à 300°C, 310°C, 200°C et 470°C, pendant la cristallisation.

5

EXEMPLE 4

Une diode à luminescence bleue, présentant un pic d'émission à 467nm et un rendement quantique externe de 0,8%, a été fabriquée par condensation de vapeur de substances chimiques organo-métalliques. La diode consistait en une couche de ZnSe de type n, ayant une concentration en véhicule de  $5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ , et une couche de ZnSe de type p, ayant une concentration en véhicule de  $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ . On a fait cristalliser les couches de type n et de type p de façon séquentielle sur un substrat de GaAs de type p. Du zinc-diméthyle ( $\text{DMétZn}$ ) et du sélénure de diéthyle ( $\text{DEtSe}$ ) ont été utilisés en tant que matériaux sources.

De l'aluminium-triméthyle ( $\text{TEtAl}$ ) et du  $\text{Li}_3\text{N}$  ont été utilisés en tant que sources de dopants respectivement de type n et de type p.

Des débits typiques de  $\text{DMétZn}$ ,  $\text{DEtSe}$ ,  $\text{TEtAl}$  et  $\text{Li}_3\text{N}$  étaient respectivement de  $1 \times 10^{-5} \text{ mole/mn}$ ,  $2 \times 10^{-5} \text{ mole/mn}$ ,  $1 \times 10^{-5} \text{ mole/mn}$  et  $3 \times 10^{-5} \text{ mole/mn}$ . La température de cristallisation était de 450°C.

EXEMPLE 5

2613136

Une diode au ZnSe à luminescence bleue, ayant la même structure que celle décrite à l'Exemple 4, a été également fabriquée par épitaxie par faisceau moléculaire à 300°C, avec utilisation de matériaux sources consistant en Zn, Se, Al (dopant de type n) et Li<sub>3</sub>N (dopant de type p). Le rendement quantique externe était de 0,2%. La longueur d'onde du pic de la bande d'émission était située à 467 nm.

## Revendications

1. Diode électroluminescente, comprenant un cristal substrat semi-conducteur, et une couche semiconductrice d'un composé II-VI, présentant une conduction de type (p), de faible résistivité, ladite couche étant déposée à partir d'une phase vapeur sur ledit cristal substrat.
2. Procédé de fabrication de la diode électroluminescente telle que définie à la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend les étapes consistant à
- 10 cristalliser en phase vapeur des couches semiconductrices de composés II-VI, présentant une conduction de type (p), de faible résistivité, sur un substrat semiconducteur, et à introduire des impuretés d'éléments du groupe Ia et leurs composés, à l'étape de cristallisation, sous la condition que le rapport du flux de l'élément du groupe IIb à l'élément du groupe VIb se situe dans la plage de 1 à 100, pour la réalisation d'un corps de base desdites couches de cristal semiconducteur du composé II-VI.
3. Procédé de fabrication de la diode électroluminescence selon la
- 20 revendication 2, caractérisé par le fait qu'on utilise du zinc (Zn), comme élément du groupe IIb, et du sélénium (Se) et du soufre (S), comme éléments du groupe VI, pour réaliser le corps de base, et qu'on introduit du lithium (Li), du sodium (Na) ou du potassium (K), comme
- 25 éléments du groupe Ia, et leurs composés, en tant qu'impuretés.

4. Diode à luminescence bleue, dotée d'une structure multi-cou-  
ches, consistant en un cristal substrat semiconducteur, des cou-  
ches semiconductrices de composés II-VI du type (n), présentant  
une résistivité spécifique de  $10^{-3}$  à  $10^3$   $\Omega$  cm, et des couches semi-  
5 conductrices de composés II-VI du type (p), présentant une résisti-  
vité spécifique de  $10^{-3}$  à  $10^3$   $\Omega$  cm, dans laquelle toutes les cou-  
ches présentent différentes compositions d'alliage, déterminées de  
façon sélective pour harmoniser les constantes de réseau entre el-  
les et qu'on les fait cristalliser en phase vapeur sur ledit cris-  
10 tal substrat semiconducteur.

5. Diode à luminescence bleue selon la revendication 4,  
caractérisée par le fait que le cristal substrat est un cristal de  
GaAs du type (n), la première couche des semiconducteurs de compo-  
15 sés II-VI est une couche de ZnSe de type (n), et la deuxième cou-  
che de semiconducteurs de composés II-VI est une couche de ZnSe de  
type (p), lesdites couches étant cristallisées à partir d'une pha-  
se vapeur sur ledit cristal substrat.

20 6. Diode à luminescence bleue selon la revendication 4,  
caractérisée par le fait que ledit cristal substrat est un cris-  
tal de GaAs de type (p), la première couche des semiconducteurs de  
composés II-VI est une couche de ZnSe de type (p), et la deuxième  
couche des semiconducteurs de composés II-VI est une couche de  
25 ZnSe de type (n), lesdites couches étant cristallisées à partir  
d'une phase vapeur sur ledit cristal substrat.

7. Procédé de fabrication d'une diode à luminescence bleue, consis-



tant à faire cristalliser en continu des couches semiconductrices de composés II-VI de conduction de type (n) et des couches semiconductrices de composés II-VI de conduction de type (p) de faible résistivité, à partir d'une phase vapeur, sur un cristal substrat semiconducteur, présentant la même constante de réseau, dans lequel on contrôle le rapport du flux de l'élément du Groupe II à l'élément du Groupe VI, pour qu'il se situe dans la plage de  $2 \times 10^{-3}$  à 10, à l'aide d'un gaz organométallique pour le groupe II et d'un hydrure gazeux pour le groupe VI.

10

8. Procédé de fabrication d'une diode à luminescence bleue selon la revendication 7, comprenant, en outre, une étape d'introduction d'impuretés d'éléments du groupe Ia, et leurs composés, pendant la cristallisation en phase vapeur.

15

9. Diode électroluminescente selon l'une des revendications 1, 4, 5 et 6,

caractérisée par le fait que la couche semiconductrice du composé II-VI contient des accepteurs d'éléments du groupe Ia et d'élé-

20 ments du groupe Vb.

2613136

1/2

Fig. 1

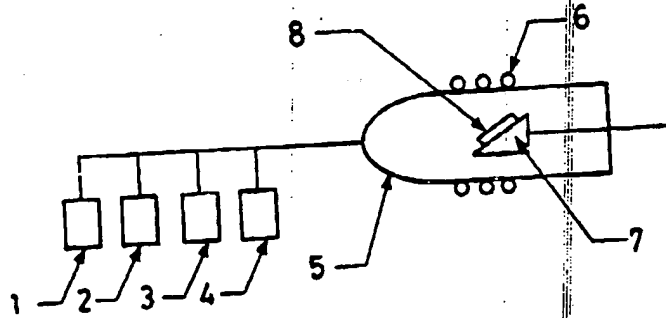


Fig. 2

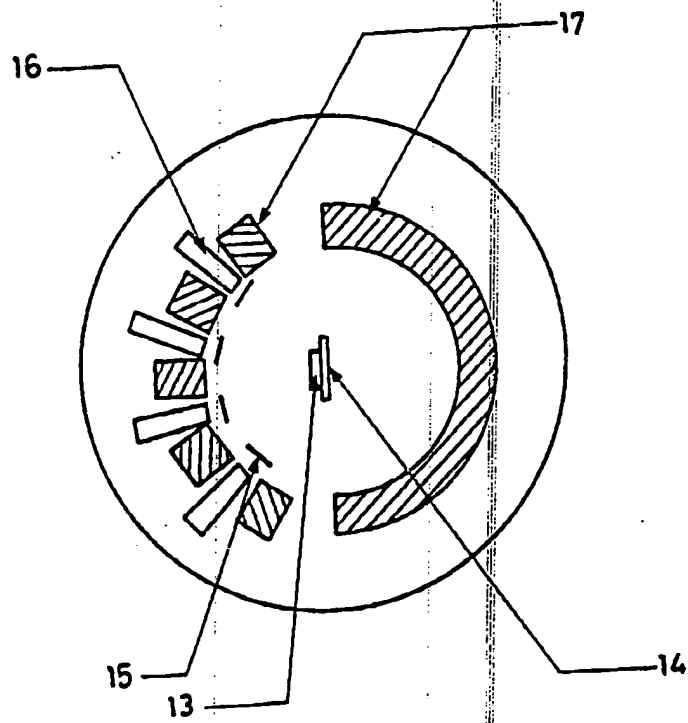


Fig. 3

